

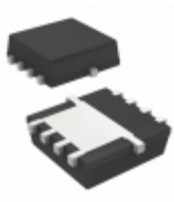







	<p>SISA18ADN-T1-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SISA18ADN-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 38.3A 1212-8</p> <p>Datenblätter:  SISA18ADN-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 16620 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SISA18ADN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 38.3A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	16620 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 250µA
Vgs (Max)	+20V, -16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.5 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	3.2W (Ta), 19.8W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Andere Namen	SISA18ADN-T1-GE3DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1000pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 38.3A (Tc) 3.2W (Ta), 19.8W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	38.3A (Tc)

SISA18ADN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SISA18ADN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SISA18ADN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SISA18ADN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SISA14DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 20A 1212-8</p>	 <p>SISA24DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 25V 60A 1212-8</p>	 <p>SISA16DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V D-S PPAK 1212-8</p>	 <p>SISA18ADN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 38.3A 1212-8</p>
 <p>SISA18DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 38.3A 1212-8</p>	 <p>SISA18ADN Vishay SISA18ADN Vishay</p>	 <p>SISA18JN-T1-GE3 VISHAY SISA18JN-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SISA16DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V D-S PPAK 1212-8</p>

SISA18ADN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	SISA18ADN-T1-GE3 Datenblatt	SISA18ADN-T1-GE3-Datenblätter	SISA18ADN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SISA18ADN-T1-GE3 Electronic	SISA18ADN-T1-GE3-Komponenten	SISA18ADN-T1-GE3-Verteiler	SISA18ADN-T1-GE3-Bild	SISA18ADN-T1-GE3
SISA18ADN-T1-GE3 Preis	SISA18ADN-T1-GE3 Hersteller	SISA18ADN-T1-GE3 Bild	SISA18ADN-T1-GE3 Aktie	SISA18ADN-T1-GE3-Teil
SISA18ADN-T1-GE3 Neu	SISA18ADN-T1-GE3 Original	SISA18ADN-T1-GE3 garantiert	SISA18ADN-T1-GE3 RFQ	SISA18ADN-T1-GE3 Inventar
				SISA18ADN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited